

表 835-11

无锡中微爱芯电子有限公司

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次:B3

编号: AiP74AHC1G09-AX-LJ-F003

AiP74AHC1G09 单路2输入与门(开漏)

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2018-05-A1	2018-05	新制
2021-09-A2	2021-09	工作温度修改为-40℃~+105℃;添加-40℃~+105℃参数表
2021-10-A3	2021-10	修改订购信息
2021-12-A4	2021-12	修改订购信息
2022-03-A5	2022-03	修改订购信息注1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次:B3

编号: AiP74AHC1G09-AX-LJ-F003

1、概 述

AiP74AHC1G09是一种高速硅栅CMOS器件。

AiP74AHC1G09提供2输入与门功能和漏极开路输出。

AiP74AHC1G09的输出是漏极开路,可以连接至其他漏极输出,以实现低电平有效,线或或高电平有效的线与功能。对于数字工作模式,该器件必须具有一个上拉电阻以建立逻辑高电平。

其主要特点如下:

表 835-11

- 电源电压范围: 2V~5.5V
- 低功耗
- 工作环境温度范围为-40℃~+105℃
- 封装形式: SOT-23-5/SOT-353



编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
AiP74AHC1G09GB235.TR	SOT-23-5	BZXX	3000 PCS/盘	30000 PCS/盒	塑封体尺寸: 2.9mm×1.6mm 引脚间距: 0.95mm
AiP74AHC1G09GC353.TR	SOT-353	BZXX	3000 PCS/盘	30000 PCS/盒	塑封体尺寸: 2.1mm×1.3mm 引脚间距: 0.65mm

注 1: "XX"为可变内容,表示年份和封装批次流水号。

注 2: 如实物与订购信息不一致,请以实物为准。

江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编: 214072

第 2 页 共 11 页 版本: 2022-03-A5



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次:B3

编号: AiP74AHC1G09-AX-LJ-F003

2、功能框图及引脚说明

表 835-11

2.1、功能框图

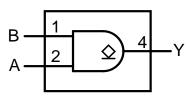


图 1 逻辑符号

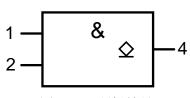
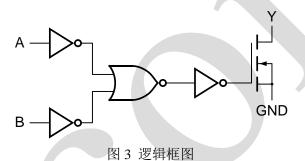
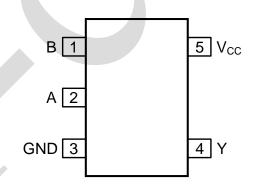


图 2 IEC 逻辑符号



2.2、引脚排列图



2.3、引脚说明

引脚	符号	功能
1	В	数据输入 B
2	A	数据输入 A
3	GND	地 (0V)
4	Y	数据输出 Y
5	V_{CC}	电源电压



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次:B3

编号: AiP74AHC1G09-AX-LJ-F003

2.4、功能表

输	入	输出
A	В	Y
L	L	L
L	Н	L
Н	L	L
Н	Н	Z

注: H=高电平; L=低电平; Z=高阻态。

3、电特性

3.1、极限参数

(除非另有规定, GND=0V)

表 835-11

参数名称	符号	条 件	最小	最大	单 位
电源电压	V_{CC}		-0.5	+7.0	V
输入电压	V_{I}	_	-0.5	+7.0	V
输入钳位电流	I_{IK}	V_{I} <-0.5 V	-20	_	mA
输出钳位电流	I_{OK}	V_{O} <-0.5 V	_	±20	mA
输出电压	V	工作模式	-0.5	+7.0	V
制 山 电压	V_{O}	高阻抗模式	-0.5	+7.0	V
输出电流	I_{O}	V ₀ >-0.5V		25	mA
电源电流	I_{CC}	_		75	mA
地电流	I_{GND}		-75		mA
贮存温度	T_{stg}		-65	+150	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
总功耗	P _{tot}			250	mW
焊接温度	$T_{ m L}$	10 秒	25	50	$^{\circ}$

3.2、推荐使用条件

参数名称	符号	条件	最小	典型	最大	单 位
电源电压	V_{CC}	_	2.0	5.0	5.5	V
输入电压	$V_{\rm I}$	_	0	_	5.5	V
输出电压	V	工作模式	0	_	V_{CC}	V
制 山 电压	V_{O}	高阻抗模式	0	_	6.0	V
工作环境温度	T_{amb}		-40	_	+105	$^{\circ}$
输入上升和下降	$\Delta t/\Delta V$	$V_{CC}=3.0V\sim3.6V$	_	_	100	ns/V
转换速率	ΔυΔν	V_{CC} =4.5 V \sim 5.5 V	_		20	ns/V



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次:B3

编号: AiP74AHC1G09-AX-LJ-F003

3.3、电气特性

3.3.1、直流参数1

表 835-11

(除非另有规定,T_{amb}=25℃,GND=0V)

参数名称	符号	狈	试条件	最小	典型	最大	单 位
育由亚龄)	高电平输入 ,,		V _{CC} =2.0V	1.5	_		V
同电干制八 电压	V_{IH}		$V_{CC}=3.0V$	2.1	_		V
七 丛			V _{CC} =5.5V	3.85	_		V
(r) 中亚(A)			V _{CC} =2.0V	_	_	0.5	V
低电平输入 电压	V_{IL}		V _{CC} =3.0V			0.9	V
七 丛			V _{CC} =5.5V	_		1.65	V
			$I_{O}=50uA; V_{CC}=2.0V$	_	0	0.1	V
化中亚松山	$V_{ m OL}$	$V_{I}=V_{IH}$ 或 V_{IL}	I _O =50uA; V _{CC} =3.0V	_	0	0.1	V
低电平输出 电压			I _O =50uA; V _{CC} =4.5V		0	0.1	V
七 丛			$I_{O}=4mA; V_{CC}=3.0V$			0.36	V
			$I_{O} = 8mA; V_{CC} = 4.5V$	_	_	0.36	V
输入漏电流	I_{I}	_	$V_{IO}=8$ mA; $V_{CC}=4.5$ V $V_{I}=5.5$ V或GND; $V_{CC}=0$ V ~ 5.5 V			±0.1	uA
截止状态输 出电流	I_{OZ}		V_{I} = V_{IH} 或 V_{IL} ; V_{O} = V_{CC} 或 GND ; V_{CC} = 5.5 V			± 0.25	uA
静态电流	I_{CC}		哎GND; I₀=0A; V _{CC} =5.5V	_		1.0	uA
输入电容	C_{I}		_		1.5	10	pF

3.3.2、直流参数 2

(除非另有规定, T_{amb}=-40℃~+85℃, GND=0V)

参数名称	符号	狈	引试条件	最小	典型	最大	单 位
高电平输入			V _{CC} =2.0V		_	_	V
向电干制八 电压	V_{IH}		$V_{CC}=3.0V$	2.1	_	_	V
电压			V _{CC} =5.5V	3.85		_	V
(f 由 亚松)			V _{CC} =2.0V	_		0.5	V
低电平输入 电压	V_{IL}		V _{CC} =3.0V	_		0.9	V
电压			V _{CC} =5.5V	_		1.65	V
	î出 V _{OL} V _I =		I _O =50uA; V _{CC} =2.0V	_		0.1	V
佐中立松山			I _O =50uA; V _{CC} =3.0V	_		0.1	V
低电平输出 电压		V_{OL}	V_{OL} $V_{I}=V_{IH}$ $\overrightarrow{\boxtimes}V_{IL}$	I _O =50uA; V _{CC} =4.5V	_	_	0.1
七 丛			$I_0=4mA; V_{CC}=3.0V$	_	_	0.44	V
			$I_0=8mA$; $V_{CC}=4.5V$	_	_	0.44	V
输入漏电流	I_{I}	·	$I_O=8mA$; $V_{CC}=4.5V$ $V_I=5.5$ $V_{CC}=0$ V_{CC}			±1.0	uA
截止状态输 出电流	I_{OZ}	$V_{I}=V_{IH}$ 或 V_{I}	_	_	±2.5	uA	
静态电流	I_{CC}	V _I =V _{CC} 或GN	I_{O} ; I_{O} =0A; V_{CC} =5.5V	_		10	uA
输入电容	C_{I}		_	_	_	10	pF



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次:B3

编号: AiP74AHC1G09-AX-LJ-F003

3.3.3、直流参数 3

表 835-11

(除非另有规定,T_{amb}=-40℃~+105℃,GND=0V)

参数名称	符号	狈	试条件	最小	典型	最大	单 位		
宣山亚岭)		V _{CC} =2.0V		1.5	_	_	V		
高电平输入 电压	V_{IH}		V _{CC} =3.0V	2.1	_		V		
七 丛		,	3.85	_		V			
低电平输入			$V_{CC}=2.0V$			0.5	V		
电压	V_{IL}		V _{CC} =3.0V	_	_	0.9	V		
电 压		$V_{CC} = 5.5 V$				1.65	V		
	低电平输出 电压 V _{OL}	$ m V_{OL}$ $ m V_{I}=V_{IH}$ 或 $ m V_{IL}$	$I_{O}=50uA; V_{CC}=2.0V$		1	0.1	V		
化由亚松山			$I_{O}=50uA; V_{CC}=3.0V$		_	0.1	V		
			$I_{O}=50uA; V_{CC}=4.5V$			0.1	V		
七匹						$I_O=4mA$; $V_{CC}=3.0V$			0.55
			$I_O=8mA$; $V_{CC}=4.5V$			0.55	V		
输入漏电流	$I_{\rm I}$	_	V_{I} =5.5V或GND; V_{CC} =0V \sim 5.5V			±2.0	uA		
截止状态输	Ţ	$V_{I}=V_{IH}$ 或 V_{I}	$V_{\rm I}=V_{\rm IH}$ 或 $V_{\rm IL}$; $V_{\rm O}=V_{\rm CC}$ 或GND;			±10.0	uA		
出电流	I_{OZ}				10.0	uA			
静态电流	I_{CC}	V _I =V _{CC} 或GN	D; $I_0=0A$; $V_{CC}=5.5V$	_		20	uA		
输入电容	C_{I}			_		10	pF		

3.3.4、交流参数 1

(除非另有规定,T_{amb}=25℃,GND=0V)

参数名称	符号	\$	测试条件		典型	最大	单 位
			$V_{CC} = 3.0 V \sim 3.6 V$				
			$C_L=15pF$	_	4.6	7.5	ns
A, B到Y的传输	4	见图5	$C_L=50pF$	_	6.5	11.0	ns
延时	t_{pd}	定图3	V_{CC} =4.5 V ~5.5 V				
			C _L =15pF	_	3.2	5.5	ns
			$C_L=50pF$	_	4.6	7.5	ns
功耗电容	C_{PD}	$C_L=50pF; f_i=$	=1MHz; V_I = GND $\sim V_{CC}$	_	5	_	pF

注:

- [1] tpd与tPZL和tPLZ相同
- [2] 典型值是在V_{CC}=3.3V或5V时测量的
- [3] CPD用于确定动态功耗(PD单位为uW)。

 $P_D = (C_{PD} \times V_{CC}^2 \times f_i \times N) + \sum (C_L \times V_{CC}^2 \times f_o)$ 其中:

f:=输入频率,单位为MHz;

f_o=输出频率,单位为MHz;

C_I=输出负载电容,单位为pF;

V_{CC}=电源电压,单位为V;

N=输入开关数;

 $\sum (C_L \times V_{CC}^2 \times f_o)$ =如果上拉电压和电阻的组合在输出端产生 V_{CC} ,则由于输出而产生功耗。

江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编: 214072



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次:B3

编号: AiP74AHC1G09-AX-LJ-F003

3.3.5、交流参数 2

表 835-11

(除非另有规定,T_{amb}=-40℃~+85℃,GND=0V)

参数名称	符号	K	测 试 条 件		典型	最大	单 位
		$V_{CC} = 3.0 V \sim 3.6 V$					
			$C_L=15pF$	1.0	_	8.5	ns
A, B到Y的传输	.	见图5	$C_L=50pF$	1.5		12.0	ns
延时	t_{pd}	定图3	V_{CC} =4.5 V ~5.5 V				
			$C_L=15pF$	1.0		6.5	ns
			$C_L=50pF$	1.5		8.0	ns

注:

- [1] tpd与tpZL和tpLZ相同。
- [2] 典型值是在V_{CC}=3.3V或5V时测量的。

3.3.6、交流参数 3

(除非另有规定, T_{amb}=-40℃~+105℃, GND=0V)

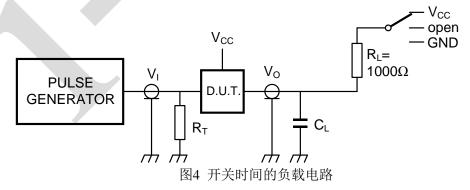
参数名称	符号	K	训试条件	最小	典型	最大	单 位
			$V_{CC} = 3.0 V \sim 3.6 V$				
			$C_L=15pF$	1.0		9.0	ns
A, B到Y的传输	•	见图5	$C_L=50pF$	1.5	_	12.5	ns
延时	t_{pd}	定图3	V_{CC} =4.5 V ~5.5 V				
			$C_L=15pF$	1.0		7.0	ns
			$C_L=50pF$	1.5		8.5	ns

注:

- [1] t_{pd}与t_{PZL}和t_{PLZ}相同。
- [2] 典型值是在V_{CC}=3.3V或5V时测量的。

4、测试线路

4.1、交流测试线路



测试电路的定义:

C_L=负载电容,包括探针、夹子上的电容

R_T=终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Z。匹配



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次:B3

编号: AiP74AHC1G09-AX-LJ-F003

4.2、交流测试波形

表 835-11

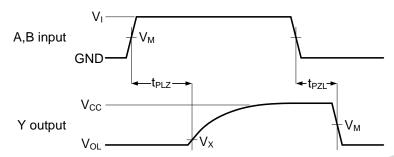


图5 数据输入(A,B)到输出(Y)传输延迟及输出转换时间

4.3、测试点

输入	输出					
$\mathbf{V}_{\mathbf{M}}$	$\mathbf{V}_{\mathbf{M}}$	$\mathbf{V}_{\mathbf{X}}$				
$0.5 \times V_{CC}$	$0.5 \times V_{CC}$	V _{OL} +0.3V				

4.4、测试数据

输入		负	载	S1		
$\mathbf{V_{I}}$	t_r , t_f	$\mathbf{R}_{\mathbf{L}}$	$C_{ m L}$	$t_{\mathrm{PHZ}},\ t_{\mathrm{PZH}}$	$t_{\rm PLZ}$, $t_{\rm PZL}$	t_{PLH} , t_{PHL}
$GND \sim V_{CC}$	≤ 3.0ns	1000Ω	15pF	GND	V_{CC}	open
$GND \sim V_{CC}$	≤ 3.0ns	1000Ω	50pF	GND	V_{CC}	open



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

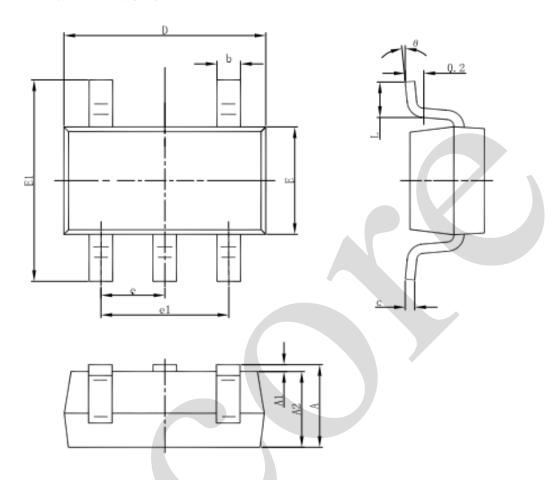
版次:B3

编号: AiP74AHC1G09-AX-LJ-F003

5、封装尺寸与外形图

5.1、SOT-23-5 外形图与封装尺寸

表 835-11



Sumb a I	Dimensions In	Millimeters	Dimensions In Inches			
Symbol	Min	Max	Min	Max		
Α	1.050	1.250	0.041	0.049		
A1	0.000	0.100	0.000	0.004		
A2	1.050	1.150	0.041	0.045		
b	0.300	0.500	0.012	0.020		
С	0.100	0.200	0.004	0.008		
D	2.820	3.020	0.111	0.119		
E	1.500	1.700	0.059	0.067		
E1	2.650	2.950	0.104	0.116		
е	0.950(BSC)	0.037(BSC)		
e1	1.800	2.000	0.071	0.079		
L	0.300	0.600	0.012	0.024		
θ	0°	8°	0°	8°		



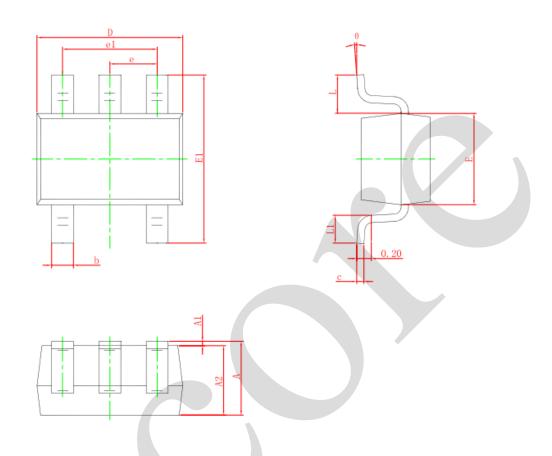
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次:B3

编号: AiP74AHC1G09-AX-LJ-F003

5.2、SOT-353 外形图与封装尺寸

表 835-11



Symbol	Dimensions	In Millimeters	Dimensions In Inches			
	Min.	Max.	Min.	Max.		
Α	0.900	1.100	0.035	0.043		
A1	0.000	0.100	0.000	0.004		
A2	0.900	1.000	0.035	0.039		
b	0.150	0.350	0.006	0.014		
С	0.080	0.150	0.003	0.006		
D	2.000	2.200	0.079	0.087		
E	1.150	1.350	0.045	0.053		
E1	2.150	2.450	0.085	0.096		
е	0.650	TYP.	0.026 TYP.			
e1	1.200	1.400	0.047	0.055		
L	0.525	REF.	0.021 REF.			
L1	0.260	0.460	0.010	0.018		
θ	0°	8°	0°	8°		



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次:B3

编号: AiP74AHC1G09-AX-LJ-F003

6、声明及注意事项

表 835-11

6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素									
部件 名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六阶铬 (Cr (VI))	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基巳 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
引线框	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塑封 树脂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芯片	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内引线	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装片胶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
说明	○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

6.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知;

本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失;

本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。